

半導体レーザーの波長制御

Wavelength Control of Diode Laser

石河直樹, 佐藤家郷, 煤田秀雄, 竹内延夫*

N.Ishikawa, I.Sato, H.Susuda, N.Takeuchi*

明星電気, 国立公害研究所*

Meisei Electric Co., National Institute on Environment Studies

あらまし 簡易・小型を特長とする半導体レーザーの波長安定化装置を製作し、可搬型レーザーレーダの光源への適用を試みた。

1. まえがき

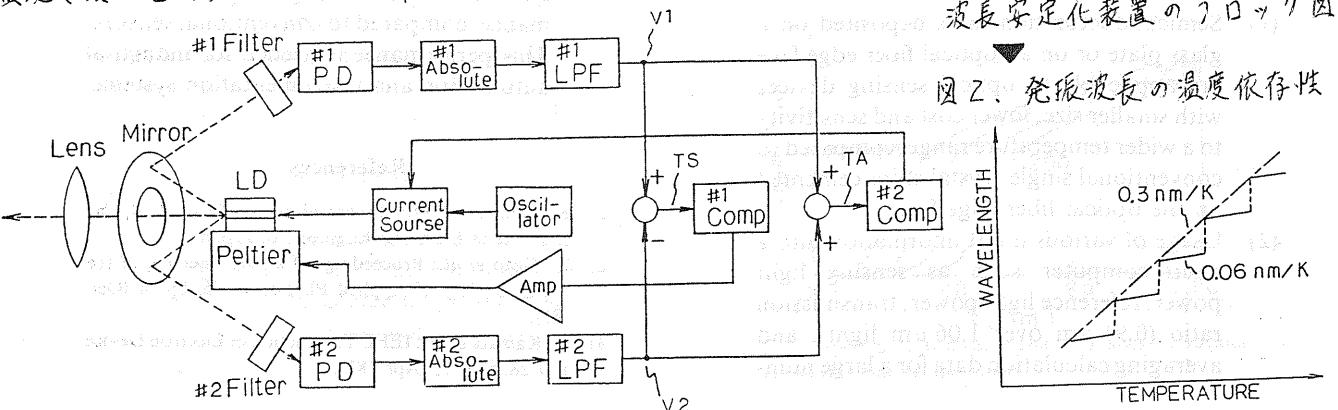
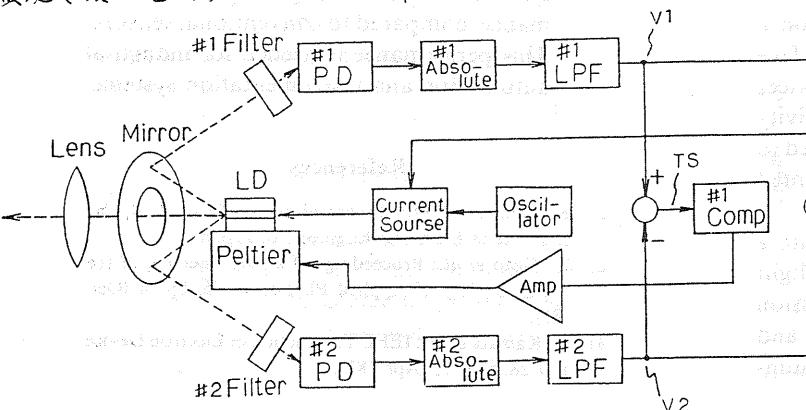
通常、レーザーレーダは昼間使用のとき、受光系の光検出器には、投射したレーザ光の反射光の他に、主に背景光が不要な雑光として入射する。この背景光は、受信信号にゆらぎを与えるたり、光検出器のショットノイズを増加させて受信信号のSN比を低下させる。従って、この背景光の光検出器への入射量を極力少なくすることが必要となる。この目的のために、投射するレーザ光の波長を透過中心波長としたバンドパスの干渉フィルタが使用される。

この干渉フィルタを狭帯域とすれば、受信信号のSN比を改善できるが、半導体レーザーの発振波長は温度により変化するため、バンド幅が約1 nmの干渉フィルタを使用する場合、半導体レーザーの波長安定化が必要となる。

2. 安定化の方法

本装置のブロック図を第1図に示す。半導体レーザーの温度を制御することにより、発振波長を安定化する方式をとっている。基準要素としては、一組の干渉フィルタを使用している。

半導体レーザーの発振波長については、素子の温度や注入電流量によって制御できることが



◆ 図1. 半導体レーザ
波長安定化装置のブロック図

図2. 発振波長の温度依存性

半導体レーザの発振波長について表わしたものである。これは、波長 λ_c でゼロクロスした特性となる。#1コンパレータは、減算器の出力レベル T_S がゼロとなるように、すなわち、半導体レーザの発振波長が波長 λ_c となるように、ペルチエ素子への電流を制御する。ペルチエ素子は入力する電流の方向により、発熱面と冷却面を切換えることができる。半導体レーザは加熱すれば長波長側に、冷却すれば短波長側に発振波長が移動するのである。

図3(C)は、加算器の出力 $T_A = V_1 - V_2$ を半導体レーザの発振波長について表わしたものである。半導体レーザの発振波長が波長 λ_c に固定されれば、加算器の出力レベル T_A は図3(C)のA点の値となり、このレベルは半導体レーザの出力レベルに比例している。#2コンパレータは予め設定された基準レベルと出力レベル T_A との結果により、電流源から半導体レーザへの注入電流を制御し、半導体レーザの発光出力を一定にしている。

3. レーザーレーダへの適用

本装置をレーザ光源として適用したレーザーレーダは、受光系の光検出器にAPDを使用し、その前面に透過中心波長 $\lambda_0 = 778.5\text{nm}$ 、半値幅 $\Delta\lambda = 1.1\text{nm}$ の干渉フィルタを使用している。図4にこの干渉フィルターの透過スペクトル曲線を示す。従って、本装置の動作原理の説明で述べた半導体レーザの固定波長 λ_c は、778.5 nmとしている。半導体レーザは、発振波長が室温(30°C)にて、783 nmのAlGaAsレーザを使用している。

本装置に要求される波長安定度は、波長変化分 $\Delta\lambda$ を発振波長 λ_c で割った値 $\Delta\lambda/\lambda_c$ が 10^{-3} 以下である必要がある。

実際には、半値幅1.1 nmの受光系の干渉フィルタを通して、半導体レーザの発光出力を測定することにより、波長安定度を評価しており、レベル変動が室温にて2%以内という結果であった。尚、この評価法では、半導体レーザの発光出力の安定度も同時に調べていることになる。

4. 簡易な半導体レーザの波長安定化装置構成

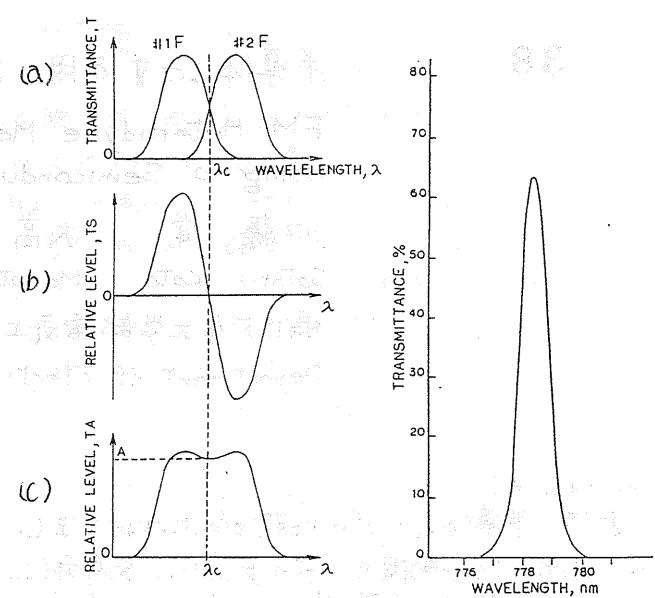


図3. 一組の干渉
フィルタの透過
スペクトル特性と
干渉フィルタ
その差と相

について紹介した。小型のレーザーレーダの光源とすることにより、背景光の受光量を減らし受信信号のS/N比の改善を目的としていた。レーザーレーダの受光系とは独立に送光系に組みるので、レーザーレーダの機構が簡単になるという特長も合わせ持っている。

文献

(1) 秋元：“半導体レーザーの周波数制御技術”，O plus E, pp. 67~79

(2) "HITACHI LASER DIODE APPLICATION MANUAL", JUNE 1979.